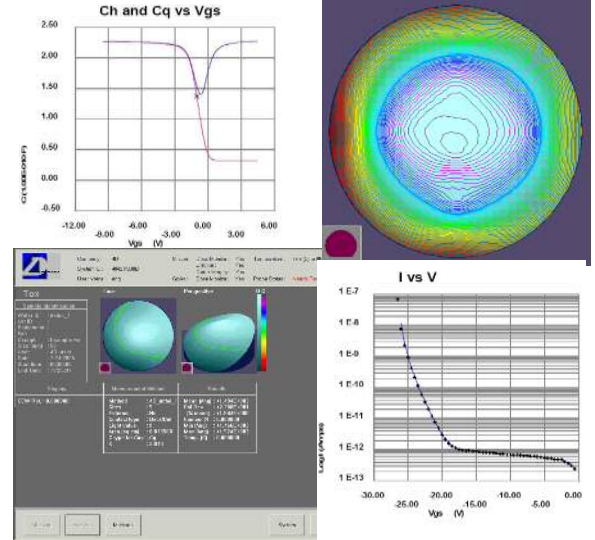


水銀プローバ CV/IV測定システムCVmap

SiC、GaNなどのパワーデバイス向け化合物半導体のキャリア濃度評価に非常に有効

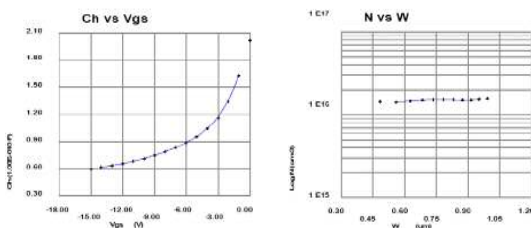


特徴

CVmapは、水銀プローブ方式を用いたCV/IV測定システムです。水銀が電極の代わりになるため、コストや時間を要する電極形成が不要です。独自のコンタクト方式は、非常に優れた再現性、安全性を実現します。SiC、GaN、Si-Epiなど、様々なタイプのウェハに対応。迅速にマッピング測定が行えます。

測定例

SiCウエハのキャリア濃度プロファイル(C-V、N-W)



主な測定項目

- ドーピングプロファイル(キャリア濃度)
- 比誘電率(Low-K、High-Kなど)
- フラットバンド電圧
- 界面トラップ、固定電荷密度
- リーク電流
- 破壊電圧測定(Vbd、TDDb)
- チャージによる破壊試験(Qbd)
- ピンホール密度縁膜膜厚、絶縁膜容量
- 強誘電体特性
- ジェネレーション・ライフタイム絶縁膜の抵抗
- Pseudo-MOSTランジスタ測定 (B-type)
- BOX界面Dit、モビリティ測定(B-type)

CVmap Seriesのラインナップ

- CVmap92A：マッピング測定対応、標準タイプ
- CVmap92B：SOIウエハ対応タイプ
- CVmap3092A、B：12インチ対応タイプ
- CV92M：マニュアル測定タイプ

※ USJウエハ対応タイプ、自動搬送付きタイプ、大型基板用タイプなど、各種取り揃えています。

【製品に関するお問合せ先】

TEL：078-304-5178 Email：info4@oyama-company.co.jp
HP：<https://www.oyama-web.com/keisoku.html>



雄山株式会社

THE OYAMA COMPANY, LIMITED